



МИКРОСХЕМА КР537УУ3А, КР537УУ3Б



## Э Т И К Е Т К А

Микросхема КР537УУ3А, КР537УУ3Б - статическое оперативное запоминающее устройство информационной емкости 4096 бит в организации 4096 x 1 бит, предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре широкого назначения.  
Климатическое исполнение - УХИ

Схема расположения выводов

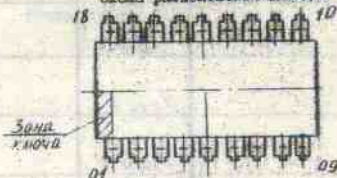


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение
01	Вход адресной строки A2
02	Вход адресной строки A3
03	Вход адресной строки A4
04	Вход адресной строки A5
05	Вход адресной строки A6
06	Вход адресной строки A7
07	Выход информационный D0
08	Вход сигнала "Защита" $\overline{VR}$
09	Общий вывод DV
10	Вход сигнала "Выбор микросхемы" $\overline{CS}$
11	Выход информационный D1
12	Вход адресной строки A8
13	Вход адресной строки A9
14	Вход адресной строки A10
15	Вход адресной строки A0
16	Вход адресной строки A1
17	Вход адресной строки A11
18	Вход питания от источника напряжения U

1044

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $\theta_a = -(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение высокого уровня, В $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $I_{OH} = -2,0 \text{ мА}$ , $U_{OH} = 2,4 \text{ В}$ , $U_{OL} = 0,8 \text{ В}$	$U_{OH}$	2,4	-
Выходное напряжение низкого уровня, В $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $I_{OL} = 4,8 \text{ мА}$ , $U_{OH} = 2,4 \text{ В}$ , $U_{OL} = 0,8 \text{ В}$	$U_{OL}$	-	0,4
Напряжение питания в режиме хранения, В $U_I = 0$ , $U_{CS} = U_{CCS}$	$U_{CCS}$	-	2,0
Ток утечки высокого уровня на входе, мкА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $U_{OH} = 5,5 \text{ В}$	$I_{LH}$	-	1,0
Ток утечки низкого уровня на входе, мкА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $U_{OL} = 0$	$I_{LH}$	-	1-1,0/
Ток утечки высокого уровня на выходе, мкА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $U_{OH} = 5,5 \text{ В}$	$I_{LOH}$	-	5,0
Ток утечки низкого уровня на выходе, мкА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $U_{OL} = 0$	$I_{LOL}$	-	1-5,0/
Ток потребления в режиме хранения, мкА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $U_{I1} = 0$ , $U_{I2} = 5,5 \text{ В}$	$I_{CCS}$	-	1,0
Время цикла считывания, нс для КР537F3A для КР537F3Б $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $C_L = 50 \text{ пФ}$	$t_{CYCL}$	-	350 250
Время выбора, нс для КР537F3A для КР537F3Б $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $C_L = 50 \text{ пФ}$	$t_{CS}$	-	230 150
Время установления сигнала выбора относительно сигнала адреса, нс $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $C_L = 50 \text{ пФ}$	$t_{SUA-CS}$	-	40
Длительность сигнала записи, нс $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $C_L = 50 \text{ пФ}$	$t_{WWR}$	-	80
Динамический ток потребления, мА $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ , $f = 1 \text{ МГц}$	$I_{CCD}$	-	5,0

Содержание драгметаллов в 1000 шт микросхем

Золото - 7,709L<sub>3</sub>

Серебро - -

в том числе:

Золото - -- г/мм на выводах длиной мм

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПЕВКЕ

Микросхемы КР537F3А, КР537F3Б соответствуют техническим условиям ОУ.348.632-03 ТУ.

Место для штампа  
ОПК

181  
ЛК

Место для штампа  
Полупроводник

Перепроверка произведена

Место для штампа  
ОПК

Место для штампа  
Полупроводник